

(44) 中華民國78年(1989)11月01日
發明

(51) Int. Cl.: B32B

全 2 頁

(54) 名 稱: 膠帶

(21) 申 請 案 號: 77107188 (22) 申 請 期 日: 中華民國77年(1988)10月18日

(72) 發 明 人: 大野昭二 日本

福島孝 日本

(71) 申 請 人: 戴亞德斯股份有限公司 日本

(74) 代 理 人: 陳燦暉 先生 洪武雄 先生

1

2

(57) 申 請 專 利 範 圍:

1. 一種膠帶，包括：一由多層紗製成之經紗與緯紗所編織成之底布，該多層紗包含有一由彈性聚烯烴樹脂層所構成之紗蕊構件，該紗蕊心構件之兩邊設有熔點較構成彈性層之聚烯烴樹脂之熔點低之聚烯烴樹脂層，經紗之丹尼數較緯紗之丹尼數低，再使經紗與緯紗之交點熱熔接；置設在底布之一邊上之聚烯烴樹脂所製成之疊積層；以及一置設在已疊積底布之一表面或兩表面上之壓感性黏著劑層。
2. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，形成為多層紗之紗蕊構件之彈性紗以及其熔點較紗蕊構件用之材料之熔點低之聚烯烴樹脂層二者皆係由選自由高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、中密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯醇、聚丙烯O、聚偏二氯乙烯、聚醋胺與聚酯等所組成之組群中之一材料所形成者。
3. 如申請專利範圍第2項所述之膠帶，其中，低熔點聚烯烴樹脂層係由其熔點為較作為彈性紗蕊構件材料用之樹脂之熔點低15~35°C之樹脂所形成者。
4. 如申請專利範圍第3項所述之膠帶，其中，低熔點聚烯烴樹脂層係由其熔點為較作為彈性紗蕊構件材料用之樹脂之熔點低20~25.
5. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，緯紗之丹尼數為經紗之丹尼數之1.5~3倍。
6. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，紗蕊構件用材料為高密度聚乙烯或聚丙烯，而低熔點樹脂層用材料為低密度聚乙烯或具有低熔點之聚丙烯。
7. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，紗蕊構件用之彈性紗之厚度及置設在該紗蕊構件之兩邊上之低熔點聚烯烴樹脂層之厚度分別為在15~55μ之間及在1~5μ之間。
8. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，紗蕊構件用之彈性紗之厚度及置設在該紗蕊構件之兩邊上之低熔點聚烯烴樹脂層之厚度分別為在20~45μ之間及在2~4μ之間。
9. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，經紗用之多層紗之寬度為在0.6~1.0mm之間，而緯紗用之多層紗之寬度為在1~1.4mm之間。
10. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶，其中，經紗之丹尼數為100~240之間，而緯紗之丹尼數為在240~480之間。

11. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其中，經紗之丹尼數為 140~200 之間，而緯紗之丹尼數為在 280~360 之間。

12. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其中，底布每單位長度之經紗數為在每英吋 25~50 之間，而底布每單位長度之緯紗數為在每英吋 12~25 之間。

13. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其中，底布每單位長度之經紗數為在每英吋 25~46 之間，而底布每單位長度之緯紗數為在每英吋 14~20 之間。

14. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其中，底布有一外表面接受電量放電處理。

15. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其中，疊積層中之厚度為在 25~50 μ 之間。

16. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其

中，構成多層紗之低熔點聚烯經樹脂係含有一無機充填物，該無機充填物係選自由二氧化矽，碳酸鈣，滑石及高嶺土等所組成之組群者。

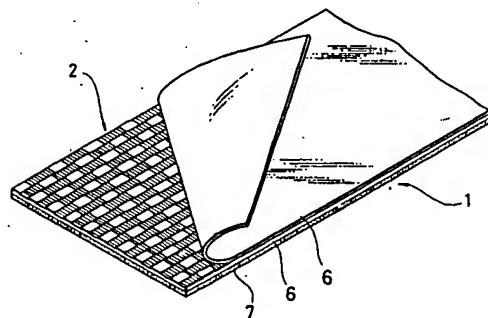
17. 如申請專利範圍第 1 項所述之膠帶，其中，底布之疊積操作係於較低熔點熱塑性合成樹脂之熔點高 130~190°C 之溫度下實施者。

圖示簡單說明：

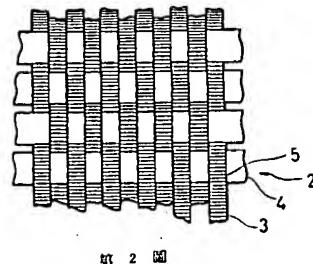
第 1 圖為本發明膠帶之實施例之透視圖，其中疊積層部分剖離：

第 2 圖為用於第 1 圖所示膠帶中之布料之放大圖：

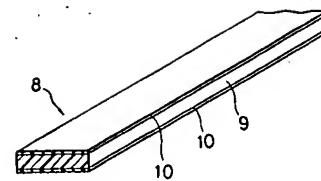
第 3 圖為供製成布料或底布用之多層紗之橫斷面圖。



第 1 圖



第 2 圖



第 3 圖